# PRÍSPEVOK K SLEDOVANIU NIEKTORÝCH TEXTÚRNYCH A ŠTRUKTÚRNYCH ZMIEN SILONOVÝCH VLÁKIEN (IV)

# V. HURT, M. JAMBRICH, M. JAVOREK

# Výskumný ústav chemických vlákien vo Svite

Polymérna textúra polymorfných vlákien, medzi ktoré patrí aj naše silonové vlákno, zahrnuje okrem určenia orientácie i kryštalitu [1, 2]. Tieto syntetické lineárne polyméry sú tvorené sčasti kryštalickou fázou, sčasti amorfnou fázou. Pretože amorfná fáza má spravidla odlišné fyzikálne vlastnosti než kryštalická fáza, aj stanovenie pomeru kryštalickej a amorfnej časti má značný praktický význam.

Na určenie kryštalického a amorfného podielu sa využíva röntgenografia [4, 5, 6, 7], infračervená spektroskopia [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14], magnetická rezonancia [15], volumetrická metóda [14] a kalorimetrická metóda [16, 17, 18, 19, 20].

V tejto práci opíšeme vplyv podmienok temperovania a dĺženia na zmeny stupňa kryštality. Súčasne sa budeme zapodievať použitými metódami.

# Experimentálna časť

### Priprava vzoriek

Na sledovanie stupňa kryštality sme použili:

a) silonovú fóliu a silonovú striž získanú priamo spod hubice, ktorú sme upravovali temperovaním jednak vo vriacej vode (silonovú fóliu 3, 5, 10, 20, 40 a 360 minút a striž získanú priamo spod hubice 30, 60, 135 a 240 minút), jednak na vzduchu pri teplotách 80, 105, 140, 160 a 180 °C za konštantnej doby (180 minút);

b) silonový vlasec, silonový praný hodváb a hodváb s monomérom, o ktorých príprave sme hovorili v práci [2].

Kryštalitu sme určovali:

1. röntgenovou metódou,

2. volumetrickou metódou (na základe zmien špecifických váh).

Definícia kryštalického podielu, ktorá je založená na výskume röntgenovými lúčmi [3], je jednoznačná z hľadiska experimentálnych kritérií, ale nemôže úplne podávať objektívny pohľad na štruktúru vysokomolekulových látok. Zmenšovaním kryštalitov selektívna difrakcia röntgenových lúčov postupne prechádza v difúzny rozptyl, takže veľmi malé oblasti dokonalého usporiadania sa budú vymykať definícii, i keď hustota uloženia a kohézna energia medzi reťazcami má tú istú hodnotu ako väčšie kryštality. Pomocou metódy špecifických váh získame trochu odlišné hodnoty, pretože špecifickú váhu budú ovplyvňovať i stupňovité prechody medzi usporiadanými a neusporiadanými oblasťami, ako aj kryštalické oblasti nepatrných rozmerov, ktoré nezachytíme röntgenovou metódou.

Pri vyhodnocovaní kryštality je preto výhodnejšie robiť vzájomné porovnanie výsledkov získaných rozličnými metódami použitím relatívnych hodnôt, ktoré vzťahujeme na určitú vzorku volenú za základ.

### 1. Stanovenie kryštality röntgenovou metódou

a) Čiastočne modifikovaná Goppelova metóda.

b) Plne automatická röntgenová komôrka.

Pri stanovení stupňa kryštality röntgenovou metódou sme použili rovnakú techniku merania, ako sme opísali v práci [2].

Černanie röntgenového filmu je spôsobené:

1. koherentným žiarením, ktoré difraktujú submikroskopické zložky s trojrozmerným usporiadaním,

2. koherentným žiarením, difraktovaným amorfným podielom.

Okrem tohto skutočne žiadúceho černania prispieva ešte k spojitému černaniu:

a) žiarenie rozptýlené vzduchom a na okrajoch clonky,

b) nekoherentné žiarenie spôsobené Comptonovým a tepelným efektom,

c) nemonochromatické žiarenie, difraktované jednak kryštalickými, jednak amorfnými zložkami,

d) nemonochromatické tvrdé žiarenie, ktoré znečisťuje  $K_{\alpha}$  žiarenie z medenej anódy.

Pri vyhodnocovaní sa musí žiarenie a až d odčítať od spojitého černania. Urobili sme však čiste korekciu na rozptyl žiarenia na vzduchu, na okrajoch clonky a na nemonochromatické tvrdé žiarenie. Ostatné korekcie sme považovali za také malé, že splývajú s chybami metodiky.

Najdôležitejším bodom pri určení stupňa kryštality je pokiaľ možno správne a pre všetky vzorky rovnako uskutočňované oddelenie plochy odpovedajúcej kryštalickej časti na mikrofotometrickej krivke.

Pri praktickom stanovení viedli sme hraničnú líniu, ktorá oddeľuje kryštalické časti od amorfných, cez priesečník, o ktorom sme hovorili v predchádzajúcej práci [2]. Tým bolo umožnené podkladať hraničnú líniu čo možno rovnakým spôsobom pri všetkých skúmaných vzorkách (obr. 1).



Obr. 1. Mikrofotometrická krivka silonového materiálu.

1. plocha odpovedajúca kryštalickej časti, 2. plocha odpovedajúca amorfnej časti, 3. tvrdé žiarenie, 4. žiarenie rozptýlené vzduchom a na okrajoch clonky, 5. krivka odpovedajúca pomocnému preparátu  $(I_{Ag})$ .

Pri vyhodnocovaní stupňa kryštality vlákien musí byť zrušená orientácia, čo sa robí tým spôsobom, že vlákna rozstriháme na malé kúsky menšie než 0,5 mm. Nastrihané malé kúsky vlákien spojíme 0,5 % roztokom arabskej gumy a presne odvážené množstvo (v našom prípade 0,01 g) natlačíme do kovovej vzorkovničky valcovitého tvaru o  $\emptyset$  3 mm a výške 1,57 mm. Takto upravené vzorky vysušíme, aby sa nezvyšovala intenzita černania difúzneho žiarenia.

#### a) Čiastočne modifikovaná Goppelova metóda

Pre naše stanovenia sme použili modifikovanú Goppelovu komôrku [21], ktorá je umiestená na pohyblivom nosiči. Ako kalibračnú látku sme upotrebili vrstvy vyredukovaného striebra (obr. 2).



Obr. 2. Röntgenogram vlákna získaný pomocou Goppelovej komôrky pri použití pomocného preparátu vyredukovaného striebra.



Obr. 3. Röntgenogram kombinácie čiastočne modifikovanej Goppelovej komôrky s automatickou komôrkou na určenie hodnoty lineárneho absorpčného koeficienta.

Získané výsledky stupňa kryštality sú zhrnuté v tab. 1.

### b) Plne automatická röntgenová komôrka

Konštantné expozície potrebné pre kvantitatívne vyhodnocovanie vzoriek sú pri plne automatickej komôrke zaručené dielčími expozíciami jednotlivých vzoriek [22, 23].

Intenzitu mikrofotometrickej krivky udávajúcej korekciu na rozptyl žiarenia na vzduchu a na okrajoch clonky treba korigovať faktorom  $e^{-\mu d}$  vzhľadom na absorpciu primárneho röntgenového žiarenia prejdeného skúmanými vzorkami, ako vyplýva z Lambert-Beerovho zákona. Pre tento účel bolo potrebné stanoviť lineárny absorpčný koeficient silonového materiálu.

Čiastočne modifikovaná Goppelova metóda nám umožnila vhodnou kombináciou s plne automatickou röntgenovou komôrkou určiť hodnotu lineárneho absorpčného koeficienta (obr. 3).

Princíp stanovenia spočíval v tom, že primárny zväzok röntgenového žiarenia dopadal buď priamo na Ag-preparát, alebo súčasne prechádzal silonovými vzorkami, ktoré mali rôznu hrúbku a rovnakú hustotu  $\varrho = 1,275$ . Konštantné expozičné podmienky boli zaručené použitím plne automatickej röntgenovej komôrky, takže po sfotometrovaní príslušných dvojpolí na röntgenových snímkach mohli sme určiť lineárny absorpčný koeficient pomocou Lambert—Beerovho zákona:

### Tabulka 1

## Goppelova metóda

	Rönt	gen	Flotačne			
Druh vzorky	, % K <sub>p</sub>	pomerné hodnoty	$\% K_p$	pomerné hodnoty		
silonová fólia 20 min. v $H_2O$ pri 100 °C	46	1	52	1		
silonová fólia 360 min. v $\rm H_2O$ pri 100 °C	48	1,043	53	1,02		
silonová fólia 180 min. pri 180 °C	52	1,13	61	1,17		
hodváb praný: 1 : 3,73 nedĺžený	40 28	1,43 1	55 42	1,31 1		
hodváb s monomérom: 1 : 2,96 1 : 3,73	31 34	1 1,1	34 38	1 1,12		
Automatická komôrka hodváb s monomérom: 1 : 2,96	40	1	34	1		
1:3,73	46	1,15	-38	1,12		

kde d = hrúbka vzorky.

Nameraná priemerná hodnota  $\mu = 6,84$  cm<sup>-1</sup>.

Masový absorpčný koeficient  $\mu_m$  pre C<sub>6</sub>H<sub>11</sub>ON vypočítaný z atómových údajov je 6,350 [24]. Ak túto hodnotu násobíme príslušnou hustotou, získame lineárny absorpčný koeficient (napríklad pre  $\varrho = 1,1275$ ,  $\mu = 7,16$  cm<sup>-1</sup>). Ako vidieť, medzi nameranou a vypočítanou hodnotou  $\mu$  je pomerne dobrá zhoda.

Pretože so zmenou kryštality mení sa aj hustota silonového materiálu, môžeme pri kombinácii röntgenovej metódy s metódou stanovenia špecifických váh vypočítať i chybu, ktorej sa dopustíme, ak zachováme dôsledne konštantnú hrúbku preparátu pri snímkovaní. Prakticky rozsah zmeny  $\varrho$  je 1,1265—1,1632, čo odpovedá zmene  $\mu$  od 7,153 do 7,386. Z rovnice (1) možno potom vypočítať chybu, ktorá je v prípade silonového materiálu ca 3 %. Technologická stupnica zmeny  $\varrho$  je však ešte menšia, takže prakticky možno i túto chybu zanedbať.

Stupeň kryštality pri röntgenometrických meraniach sa určil podľa vzťahu

$$K_p = -\frac{K}{A+K} .100, \qquad (2)$$

kde  $K_p = \%$  kryštality

- K =plocha prislúchajúca kryštalickým oblastiam,
- A = plocha difúzneho černania, ktorá je v prípade čiastočne modifikovanej Goppelovej metódy korigovaná na rozptyl žiarenia vzduchom a na okrajoch clonky a pri plne automatickej komôrke zahrnuje ešte ďalšiu korekciu na tvrdé nemonochromatické žiarenie.

Jednotlivé plochy sa stanovili planimetricky. Hodnoty stupňa kryštality získané na plne automatickej komôrke sú uvedené v tab. 1.

#### 2. Volumetrická metóda

Princíp stanovenia stupňa kryštality spočíva v sledovaní špecifického objemu, resp. špecifických váh za predpokladu, že zmena špecifického objemu je úmerná zmene kryštalickej časti [28].

Špecifický objem amorfných oblastí stanovili I. Sandeman a K. Keller [14] extrapoláciou zo závislosti špecifického objemu a extinkcie infračervenej absorpčnej spektroskopie.

Pre polyamid 6 hodnota  $1/V_a$  sa uvádza 1,1 [14], pre  $1/V_k$  1,212 [25] a 1,23 [26]. Pre naše sledovanie sme použili hodnoty  $1/V_a = 1,1$  a  $1/V_k = 1,212$ ; 1/V sme stanovili flotačnou metódou.

Stupeň kryštality pomocou špecifických váh sa vypočíta:

$$K_{p} = -\frac{\frac{1}{d_{a}} - \frac{1}{d}}{\frac{1}{d_{a}} - \frac{1}{d_{k}}},$$
(3)

kde  $K_p = \text{kryštalický podiel},$ 

 $d_{a}$  = špecifická váha úplne amorfného polyméru,

- d = špecifická váha meranej vzorky,
- $d_k$  = špecifická váha úplne kryštalického polyméru.

 $d_k$  sa vypočíta z rozmerov elementárnej bunky, d môžeme stanoviť.

Špecifické váhy sledovaných vzoriek sme stanovili flotačnou metódou. Ako základnú kvapalinu sme použili benzén chemicky čistý (špec. váha 0,8796), do ktorého sme pridávali tetrachlórmetán chemicky čistý (špec. váha 1,594).

Ak pre oblasť špecifických váh 1,1-1,212 je závislosť špecifickej váhy od objemu pridávanej kvapaliny lineárna, vzťah (3) môžeme upraviť pre flotačnú metódu:

$$K_{p} = \frac{d_{k} \left(\frac{K+G-d_{a}}{K'+V_{\text{CCl4}}}\right)}{d_{k}-d_{a} \left(\frac{K+G}{K'+V_{\text{CCl4}}}\right)}$$
(4)

· Po dosadení za  $d_a = 1,1$ 

 $d_k = 1,212$ K' = 20 ml benzénu

 $V_{\rm CCL}$  = ml tetrachlórmetánu

$$K = 20.0,8796$$

 $G = V_{\text{CCl}_1} \text{ v ml.} 1,594$ 

a po čiastočnom zjednodušení získame vzťah

$$K_p = \frac{(0.6 \ V_{\rm CC14} - 5.34)}{(1.97 + 0.1785 \ V_{\rm CC14})} \tag{5}$$

 $V_{\rm CC1_1}$ odpovedá stanoveniu pri teplote 20 °C.

Hodnoty stupňa kryštality získané zo vzťahu (5) sú zhodné s údajmi v literatúre [27].

Dosiahnuté hodnoty sú uvedené v tab. 2 až 6.

	Kryštalický podiel v %								
Druh vzorky	netemp.	80 °C	105 °C	140 °C	160 °C	180 °C			
silonová striž získaná spod hu- bice	31	32	39	46	61				
silonová fólia	30	35	38	47	52	61			

Tabuľka 2

Tabuľka 3

Druh vzorky	Kryštalický podiel v %										
	netemp.	3′	5'	10'	20'	30'	40'	60′	135'	240'	360'
silonová fólia	30	48	49	51	52		53				53
silonová striž získaná spod hubice	31		_	51	51	51	52	51	52	53	53

Tabuľka 4

	Kryštalický podiel v %							
Druh vzorky	nedĺžený	1:2,96	1:3,28	1:3,54	1:3,73			
silonový hodváb praný	42	50	52	53	55			
silonový hodváb s monomérom	29	34			38			

	Kryštalický podiel v %								
Druh vzorky	1:2,6	1:3,2	1:3,75	1:4,0	nedĺ- žený	dĺžený			
silonový vlasec	54	52	52	52		-			
silonový vlasec s monomérom		—			30	38			

Tabulka 5

# Tabulka 6

Druh vzorky	Kryštalický podiel v %								
	spod hubice	prvé valčeky	1:1,7	1:2,6	1:3,5				
silonová striž s monomérom	31,0	27,8	28	28	31,5				
silonová striž praná	-	-	40	41	45,8				

## Diskusia

Stupeň kryštality rozličného silonového materiálu, ktorý bol upravovaný temperáciou a dĺžením, pohybuje sa pri röntgenometrickom meraní od 28 % do 52 % a podľa špecifických váh určených flotačnou metódou od 28 % do 61 %.

Na percentuálne vyjadrenie stupňa kryštality uvedenými metódami treba pozerať ako na približné hodnoty, pretože nemá nijaký význam hovoriť o určení kryštality v absolútnych hodnotách, keďže každá z týchto metód závisí od definície kryštalického podielu. Pre vzájomné porovnanie výsledkov, ktoré sme získali obidvoma uvedenými metódami, urobili sme vyčíslenie v relatívnych hodnotách. Stanovené hodnoty sú porovnávané pre určitú vzorku zvolenú za základ. V tab. 1 vidíme, že je dosť dobrá zhoda v relatívnych hodnotách získaných obidvoma metódami. Jednotlivé nezrovnalosti sú spôsobené rozdielnou citlivosťou a presnosťou vyhodnocovania obidvoma metódami.

Výhoda kombinácie obidvoch metód spočíva v ich rozdielnych možnostiach. Kryštalitu určenú pomocou špecifických váh možno pri všetkých vzorkách pomerne rýchlo vyhodnotiť, zatiaľ čo röntgenometrické meranie stupňa kryštality umožňuje len vzájomné porovnanie vzoriek s kryštálovou monoklinickou štruktúrou (toto obmedzenie sa však týka modelových vzoriek silonového materiálu spracovaného v hmote, pretože výsledné produkty, ako hodváb, striž alebo vlasec, majú po vydĺžení monoklinickú modifikáciu). Naproti tomu röntgenová metóda umožňuje sledovať zmeny kryštálových modifikácií hoci len kvalitatívne. Ide predovšetkým o prechodnú smektickohexagonálnu modifikáciu, o zmes smekticko-hexagonálnej a monoklinickej modifikácie, o nestabilnú  $\beta$ -formu monoklinickej modifikácie a o zmes  $\alpha$ -formy s $\beta$ -formou a pod. Vzájomné spojenie röntgenovej metódy s určením špecifických váh dáva teda ucelenejší pohľad na štruktúru.

Obidva spôsoby temperovania uvedené v experimentálnej časti majú rozdielny vplyv na výsledný stupeň kryštality Úprava vzoriek temperovaním vo vode pri 100 °C predstavuje vlastne zmenu za prítomnosti napučiavadla, čo i pri pomerne nízkej teplote (100 °C) umožňuje rýchlu premenu smekticko-hexagonálnej modifikácie na monoklinickú modifikáciu [1]. Ďalším temperovaním nastáva zdokonaľovanie kryštálovej monoklinickej mriežky, ako to vyplýva zo zostrenia difrakčných kruhov a zo zvýšenia kryštalického podielu na úkor amorfných oblastí. Je zaujímavé, že už po 40 min. temperovania vo vode získame maximum kryštality, ktoré v prípade silonového materiálu sa pohybuje okolo 53 %. Ďalším predlžovaním doby temperovania neprejaví sa pozorovateľný vplyv na vzrast kryštalického podielu.

Naproti tomu temperovaním silonových vzoriek pri 180 °C na vzduchu rýchlosť premeny smekticko-hexagonálnej modifikácie na monoklinickú je pomalšia v porovnaní s temperovaním vo vode, avšak maximum kryštality získame až ca 61 %. Tak isto dokonalosť kryštálovej mriežky je vyššia, ako to vyplýva z väčšej ostrosti difrakčných kruhov alebo z ich pomeru intenzít černania (020) + (220) ku (200). Vysvetlenie treba hľadať v rozdielnej akumulácii energie pozdĺž lineárnych reťazcových molekúl, ktorá je pri 180 °C omnoho vyššia a umožňuje väčšie rotačné a čiastočne translačné pohyby jednotlivých segmentov makromolekúl. Oboje má priaznivý vplyv na ich usporiadanie v dokonalejšiu trojrozmernú monoklinickú mriežku.

O vplyve dĺženia na kryštality nie sú ešte úplne jednotné názory. Napríklad W. Brenschede [29] na základe pokusov s polyuretánom popiera vplyv preťahovania na usporiadanie mriežky. Naproti tomu H. Böhringer [30] zistil pri dĺženom polyamide 6 zvýšenie hustoty, zatiaľ čo I. Sandeman a A. Keller [14] zistili dvojaký vplyv dĺženia na množstvo kryštality. Pri polyamide 6 kryštalita s dĺžením stúpa, kým pri polyamide 610 sa znižuje. Skutočnosť, že kryštalita podobných polyamidov je opačne ovplyvňovaná dĺžením, ukazuje názorne zložitosť orientačného procesu, ktorý za dnešných znalostí nemôže byť ešte jednoznačne vysvetlený.

Skúmali sme vplyv dĺženia na kryštalitu silonového hodvábu a vlasca za prítomnosti monoméru (10 %). Vlasec sme dĺžili podľa teleskopického efektu a hodváb na pomer 1 : 3,75. Pri porovnaní obidvoch výsledkov vysvitá,

že vzrast kryštality je ca 10 %. To znamená, že aj dĺženie môže do určitej miery ovplyvniť dokonalosť usporiadania (zvýšenie kryštalického podielu) i keď omnoho v menšej miere než úprava temperovaním.

# Súhrn

V tejto časti práce sme sa zapodievali stanovením kryštality silonových materiálov, ktoré sme upravovali dĺžením a temperovaním na vzduchu a vo vode. Kryštalitu sme vyhodnocovali röntgenovými metódami:

a) modifikovanou Goppelovou metódou,

· b) automatickou komôrkou

a stanovením špecifických váh.

Zistilo sa, že temperovanie vo vode alebo na vzduchu má rozdielny vplyv nielen na rýchlosť premeny štruktúrnych modifikácií, ale aj na výsledný stupeň kryštality.

Silonové materiály temperované vo vode pri 100 °C dosiahli maximálny stupeň kryštality 53 %, naproti tomu temperovaním pri 180 °C až 61 %. Dĺžením silonových vlákien vzrastá stupeň kryštality ca o 10 %.

Pre vzájomné porovnanie výsledkov získaných obidvoma metódami použili sme pomerné hodnoty, ktoré vzťahujeme na určitú vzorku zvolenú za základ.

# ЗАМЕТКА К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕКОТОРЫХ ТЕКСТУРНЫХ И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СИЛОНОВЫХ ВОЛОКОН (IV)

## В. ГУРТ, М. ЯМБРИХ, М. ЯВОРЕК

### Исследовательский институт химических волокон в Свите

### Выводы

В этой части работы говорится об определении кристалличности силоновых материалов, которые мы приготовили вытяжкой и темперированием на воздухе и в воде. Кристалличность мы оценивали рентгеновскими методами:

а) модифицированным методом Гоппеля,

б) автоматической камерой

и определением удельных весов.

Было обнаружено, что темперирование в воде или же на воздухе имеет различное влияние не только на скорость изменений структурных модификаций, но и на результаты степени кристалличности.

Силоновые материалы, темперпрованные в воде при 100 °С достигли максимальной степени кристалличности 53 %, тогда как темперированием при 180 °С было получено 61 %. Вытяжкой силоновых волокон возрастает степень кристалличности приблизительно на 10 %.

К взаимному сравнению результатов, полученных обема методами, мы применили относительные значения по отношению к определенному образцу, взятому за основание.

# BEITRAG ZUR UNTERSUCHUNG EINIGER TEXTUR-UND STRUKTURÄNDERUNGEN VON SILONFASERN (IV)

### V. HURT, M. JAMBRICH, M. JAVOREK

### Forschungsinstitut für Chemiefasern in Svit

#### Zusammenfassung

In diesem Teile ihrer Arbeit behandeln die Autoren die Bestimmung der Kristallinität von Silonmaterialien, welche durch Streckung und Temperierung an der Luft und im Wasser behandelt wurden. Die Kristallinität wurde mit Hilfe von Röntgenmethoden ausgewertet, u. zw.:

a) durch die modifizierte Goppel-Methode,

b) durch die automatische Kammer und durch die Bestimmung der spezifischen Gewichte.

Es wurde festgestellt, dass die Temperierung im Wasser oder an der Luft einen unterschiedlichen Einfluss nicht nur auf die Geschwindigkeit der Veränderungen der Strukturmodifikationen ausübt, sondern auch auf den resultierenden Kristallinitätsgrad.

Silonmaterialien, die im Wasser bei 100 °C temperiert wurden, erreichten den maximalen Kristallinitätsgrad 53 %, demgegenüber erhielt man durch Temperierung bei 180 °C bis zu 61 %. Durch Streckung von Silonfasern wuchs der Kristallinitätsgrad um ca. 10 % an.

Zum gegenseitigen Vergleich der äurch diese beiden Methoden erhaltenen Ergebnisse benützten die Autoren Verhältniswerte, welche zu einem bestimmten Muster, das als Grundlage gewählt wurde, bezogen wurden.

In die Redaktion eingelangt den 15. 8. 1958

## LITERATÚRA

1. Jambrich M., Hurt V., Chem. zvesti 12, 401 (1958). — 2. Hurt V., Jambrich M., Chem. zvesti 12, 496 (1958). — 3. Hermans P. H., *Physics and Chemistry of Cellulose Fibres*, New York, Amsterdam 1949. — 4. Field J. E., J. Appl. Phys. 12, 23 (1941). — 5. Hermans P. H., Weidinger A., J. Appl. Phys. 19, 491 (1948). — 6. Hermans P. H., Weidinger A., Kolloid-Z. 115, 103 (1949). — 7. Hermans P. H., Weidinger A., Kolloid-Z. 115, 103 (1949). — 7. Hermans P. H., Weidinger A., 370 (1951). — 9. Morhel W. E., Hall M. B., J. Am. Chem. Soc. 71, 4082 (1949). — 10. Cobbs W. H., Burton R. L., J. Polymer Sci. 10, 275 (1953).

11. Nichols J. B., J. Appl. Phys. 25, 840 (1954). — 12. Keller A., Sandeman I., J. Polymer Sci. 13, 511 (1954). — 13. Zhurkov S. N., Lovon B. Y., Dokl. Akad. nauk SSSR, 67, 89 (1949). — 14. Sandeman I., Keller A., J. Polymer Sci. 19, 401 (1956). — 15. Wilson G. W., Parker G. E., J. Polymer Sci. 10, 503 (1953). — 16. Michajlov I. V., Fajnberg E. Z., Kolloid. ž. 18, 3, 315 (1956). — 17. Dóle M., Hettinger W. R., Larson N. R., Wethington J. A., J. Chem. Phys. 20, 781 (1952). — 18. Wilhoit R. C., Dóle M., J. Phys. Chem. 57, 14 (1953). — 19. Calvet E., Hermans P. H., J. Polymer Sci. 6, 33 (1951). — 20. Parks G. S., Mosley J. R., J. Chem. Phys. 17, 691 (1949).

21. Goppel J. M., Appl. Sci. Res. (A) *I*, 18 (1947). — 22. Kochanovská A., Papír a celulosa, č. 4, 84 (1954). — 23. Kozler M., Záverečná zpráva VÚCHV, Svit 1957. — 24. Internationale Tabellen zur Bestimmung von Kristallstrukturen, Berlin 1935.
— 25. Okada A., Fuchino K., Chem. High Polymers (Japan) 7, 122 (1950). —
26. Holmes D. R., Bunn C. W., Smith I., J. Polymer Sci. 17, 159 (1955). —
27. Fujino K., Kawai H., Horino T., Miyamoto K., Text. Res. J. 26, 852 (1956). —
28. Hunter E., Oakes W. G., Trans. Faraday Soc. 41, 49 (1945). —
29. Brensche de W., Z. Elektrochem. 54, 191 (1950). —
30. Böhringer H., Faserforsch. Textiltechn. 3, 381 (1952).

Do redakcie došlo 15. 8. 1958

### Adresa autorov:

Inž. Vratislav Hurt, inž. Martin Jambrich, inž. Miroslav Javorek, Svit. okres Poprad, Výskumný ústav chemických vlákien.